ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОТЫ ВЫХОДА ОТ РАЗМЕРОВ И ЗАРЯДА ЧАСТИЦ Бородин В.И.

Петрозаводский государственный университет

При тепловом взаимодействии частицы вещества с высокоионизованной средой необходимо учитывать энергообмен за счет столкновений частицы с электронами и ионами и выделение дополнительной энергии связи (работы выхода). Знание величины работы выхода с достаточной точностью является необходимым и зачастую определяет успешность проводимых расчетов.

Определению величины работы выхода веществ посвящено большое число работ [1], однако их результаты получены для достаточно больших по размерам образцов и не могут быть прямо перенесены на мелкодисперсные системы.

Одно из первых объяснений физической природы работы выхода металлов было предложено Дебаем и Шоттки, считавшими ее как работу, совершаемую против сил взаимодействия электрона с индуцированными им на поверхности металла зарядами, то есть против поляризационной силы (силы электрического изображения):

$$F = e^2/4x^2,\tag{1}$$

где *х* – расстояние от поверхности металла.

Полагал, что работа выхода и есть работа против этих сил, Шоттки и Ленгмюр получили для нее выражение [2]:

$$W = e\varphi = e^2/2\ell, \tag{2}$$

где ℓ - критическая длина, порядка атомного размера, до которой выполняется (1). Квантовомеханическое рассмотрение Бардиным поляризационных изменений энергии электронов в металле привело к выражению, совпадающему с формулой (2) [2].

Однако, как показали исследования, работа против поляризационных сил является только частью работы выхода, к которой приводила теория металлов Зоммерфельда. Дополнительной причиной, вызывающей скачек потенциала на границе металла, является двойной электрический слой на его поверхности. Возникновение его объясняется как с классической, так и с квантово-механической точки зрения [2].

Предпринималось много попыток теоретических расчетов работы выхода, однако как показывает анализ [1], рассчитать работу с удовлетворительной точностью не удается. В сложившейся ситуации часто при анализе изменения работы выхода оперируют только с ее поляризационной частью, которая составляет основную часть работы выхода, и которая хорошо моделируется с помощью сил электрического изображения.

При переходе к дисперсным средам добавляются сложности, связанные с их размерными свойствами. Рассмотрим вопрос об изменении работы выхода частиц металлов от их размеров, используя только поляризационную часть работы выхода с использованием формулы (2). В качестве ℓ выберем среднее расстояние между атомами d. Именно до таких расстояний (~ 0,3 нм) было экспериментально проверена формула (1) [3]. Поскольку сила изображения (1), строго говоря, справедлива только для взаимодействия заряда с плоской поверхностью, то при расчетах использовалась также точное выражение для силы взаимодействия точечного заряда с проводящей сферой [4]:

$$F = \frac{1}{4pee_0} \left\{ \frac{Qq}{a^2} - \frac{q^2 R^3 (2a^2 - R^2)}{a^3 (a^2 - R^2)^2} \right\},$$
 (3)

где q, Q – точечный заряд и заряд сферы соответственно, R – радиус сферы, a – расстояние от точечного заряда до центра сферы.

Из формулы (2) видно, что работа выхода равна удвоенному потенциалу силы изображения в точке ℓ (в системе СИ): $U_{u_3} = -e^{2/(16\pi\varepsilon_0 \ell)}$ (4)

Аналогичным образом для определения работы выхода с использованием силы (3) будем брать ее удвоенный потенциал, который определяется формулой:

$$U = \frac{1}{4pee_0} \left\{ \frac{Qq}{a} - \frac{q^2 R^3}{2a^2 (a^2 - R^2)} \right\}.$$
 (5)

При этом имеет место соотношение: $\ell = a - R$.

Поскольку, вводимые в плазму частицы материала заряжаются и участвуют в теплообмене с плазмой в заряженном состоянии, то необходимо рассмотреть вопрос об изменении работы выхода с изменением заряда частицы. Заряженная частица создает вокруг себя электрическое поле, и в потенциале (4) появится дополнительно кулоновский потенциал:

$$Uu3 = -\frac{e^2}{16pee_0\mathbf{l}} - \frac{eQ}{4pee_0(R+\mathbf{l})}.$$
 (6)



Таблица 1. Зависимость поляризационной части работы выхода W частиц от их размеров и заряда Q

Была рассчитана зависимость работы выхода металла от радиуса частицы для d = 0.25 нм. Соответствующие результаты приведены на рисунке (при Q = 0). Из рисунка видно, что заметный размерный эффект изменения работы выхода (в данном случае, ее уменьшение) появляется для частиц радиуса R < 10 нм, а формула для силы изображения (1) точно описывает силовое взаимодействие электрона с частицами радиуса R > 0.1 мкм. При отрицательном заряде частиц их работа выхода уменьшается. Начиная с заряда частиц Q = 10e и выше в расчетных формулах превалируют кулоновские члены, и они дают практически одинаковые результаты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Фоменко В. С., Подчерняева И. А. Эмиссионные и адсорбционные свойства веществ и материалов. М.: Атомиздат, 1975. 320 с.

2. Добрецов Л. Н., Гомоюнова М. В. Эмиссионная электроника. М.: Наука, 1966. 564 с

3. Термоэмиссионные преобразователи и низкотемпературная плазма / Под. ред. Б. Я. Мойжеса и Г. Е. Пикуса. М.: Наука, 1973. 480 с.

4. Смайт В. Электростатика и электродинамика. М.: ИЛ, 1954. 604 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ ТОПОЛОГИИ ИМС НА ОСНОВЕ ДИФРАКТОМЕТРИИ В МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Истомина Н.Л., Спыну М.В. «МАТИ» Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского

В настоящее время размеры элементов топологии (ЭТ) интегральных микросхем находятся в субмикронном диапазоне. Измерение геометрических размеров при этом связано с созданием метрологического обеспечения [1-3]. Имеющиеся математические модели индикатрис, разработанные для шероховатых металлических поверхностей [4], не подходят для описания излучения, отраженного от периодической структуры, в виде решетки.

В работе [2] показано, что реально получаемым ЭТ соответствует модель трапециевидного профиля с запыленными боковыми поверхностями. Причем их угол наклона сильно влияет на относительную интенсивность дифракционного спектра. В плоскости падения излучения решение получено в приближении скалярной теории дифракции на поверхности сложной формы, представляющей собой трапециевидную периодическую структуру с периодом d, нижним основанием трапеции (a+b), верхним основанием трапеции b и высотой трапеции h. Эффект взаимодействия между падающим излучением и поверхностью ЭТ выражается в виде отдельной фазовой задержки $\exp\{i^*k^*F(x)\}$, где k - волновое число, а F(x) - функциональная зависимость, выражающая форму профиля поверхности ЭТ, которая с помощью Фурье преобразования может быть выражена как

$$\exp\{i \times k \times F(x)\} = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} B_n \cdot B_n$$

Через вычисления коэффициентов разложения B_n получено выражение для определения интенсивности отражаемого от трапециевидной решетки монохроматического излучения в дальней зоне для экстремальных точек - главных дифракционных максимумов.